

公開番号 又は 特許番号	特開 2012-227440
発明名称	シリコン基板のエッチング方法、及びシリコン基板のエッチング装置
出願人 又は 権利者	株式会社 アルバック
想定デバイス	その他
要約	<p><b>【利用分野】</b> シリコン基板のエッチング方法、特にシリコン基板を異方的にエッチングする方法、及び該方法を用いるシリコン基板のエッチング装置に関するもの。</p> <p><b>【発明の内容】</b> シリコン基板に形成される凹部の加工精度を高めることのできるシリコン基板のエッチング方法及び該方法を用いるシリコン基板のエッチング装置を提供する。そのために、シリコン基板に対してその厚さ方向に延びる凹部を形成する際に、シリコン基板を含む基板Sを収容する真空槽11内に六フッ化硫黄（SF<sub>6</sub>）ガスのプラズマを生成して、該シリコン基板の厚さ方向に延びる凹部を形成する。加えて、真空槽11内に三フッ化ホウ素（BF<sub>3</sub>）ガスのプラズマを生成して、上記凹部の内壁面にホウ素とシリコンとを含む保護膜を形成する。</p>
図面	